

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 1 区分
 【発行日】平成 19 年 5 月 31 日 (2007.5.31)

【公開番号】特開 2001-294411 (P2001-294411A)
 【公開日】平成 13 年 10 月 23 日 (2001.10.23)
 【出願番号】特願 2000-104926 (P2000-104926)
 【国際特許分類】

C 0 1 B 25/32 (2006.01)
A 6 1 L 27/00 (2006.01)
H 0 1 L 21/314 (2006.01)
H 0 1 L 21/822 (2006.01)
H 0 1 L 27/04 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 25/32 G
 A 6 1 L 27/00 U
 H 0 1 L 21/314 A
 H 0 1 L 27/04 C

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 4 月 5 日 (2007.4.5)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基材上にアパタイト層が、積層した部分と、積層しない部分及び / 又はそれらの組合せを含む微細構造体。

【請求項 2】 前記のアパタイト層が、置換されていてもよいヒドロキシアパタイトである、請求項 1 記載の構造体。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 記載の構造体を、それぞれ異なる又は同一のパターンで繰り返し形成させた微細積層構造体。

【請求項 4】 (a) 基材の少なくとも 1 の面において、アパタイト層を形成させない領域を、被覆材で被覆する工程；

(b) アパタイト層を形成させる工程；並びに

(c) 被覆材を除去する工程

を含む、基材の表面に、所望のパターン又は微細構造体を有するアパタイト層を形成させる方法。

【請求項 5】 前記 (b) 工程において、Ca イオンが、 $0.02 \sim 25 \text{ mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ 、及び P イオン (P 含有陰イオンとして含まれるリンの量) が、 $0.1 \sim 10 \text{ mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ 含まれ、pH が 6 ~ 8 である溶液を用いることを特徴とする、請求項 4 記載の方法。

【請求項 6】 活性物質の存在下に、前記工程 (b) を行うことを特徴とする、請求項 4 又は 5 記載の方法。

【請求項 7】 前記の基材が、活性物質である、請求項 4 ~ 6 記載のいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 8】 前記の被覆材が、ホトレジストである、請求項 4 ~ 7 のいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 9】 前記のアパタイト層が、置換されていてもよいヒドロキシアパタイトである、請求項 4 ~ 8 のいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 10】 請求項 4 ~ 9 のいずれか 1 項記載の方法によって微細構造体又はパターンを形成された電子素子。

【請求項 11】 請求項 4 ~ 9 のいずれか 1 項記載の方法によって微細構造体又はパターンを形成された生体適合材。